【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和6年9月3日(2024.9.3)

【国際公開番号】WO2022/049455
【出願番号】特願2022-546729(P2022-546729)
【国際特許分類】
Ｇ０５Ｆ　3/24(2006.01)
Ｈ０２Ｊ　7/00(2006.01)
Ｈ０２Ｊ　1/00(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０５Ｆ　3/24
Ｈ０２Ｊ　7/00　３０２Ｂ
Ｈ０２Ｊ　1/00　３０６Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月23日(2024.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１トランジスタと、
第１電圧を生成する第１電圧生成回路と、
第２電圧を生成する第２電圧生成回路と、を有し、
前記第１電圧生成回路は、第２トランジスタおよび第１容量を有し、
前記第２電圧生成回路は、第３トランジスタおよび第２容量を有し、
前記第１電圧と、前記第２電圧と、の差は、前記第１トランジスタのしきい値電圧に応じて設定される、二次電池の制御回路。
【請求項２】
第１トランジスタと、
第１電圧を生成する第１電圧生成回路と、
第２電圧を生成する第２電圧生成回路と、
電圧保持回路と、を有し、
前記第１電圧生成回路は、第２トランジスタおよび第１容量を有し、
前記第２電圧生成回路は、第３トランジスタおよび第２容量を有し、
前記第１トランジスタは、バックゲートを有し、
前記電圧保持回路は、前記バックゲートの電圧を保持する機能を有し、
前記第１電圧と、前記第２電圧と、の差は、前記第１トランジスタのしきい値電圧に応じて設定される、二次電池の制御回路。
【請求項３】
請求項２において、
前記電圧保持回路は、第４トランジスタおよび第３容量を有し、
前記第３容量は、一対の電極の間に強誘電体層を有し、
前記第３容量は、前記強誘電体層を分極反転させる電圧が印加されることで、前記バックゲートに印加する電圧を保持する、二次電池の制御回路。
【請求項４】
請求項３において、

前記強誘電体層は、酸化ハフニウムおよび／または酸化ジルコニウムを有する、二次電池の制御回路。

【請求項５】

請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記第１トランジスタ乃至第３トランジスタは、チャネルに酸化物半導体を有するトランジスタである、二次電池の制御回路。

【請求項６】

請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記第１トランジスタ乃至第３トランジスタは、チャネルにインジウム酸化物を有するトランジスタである、二次電池の制御回路。

【請求項７】

請求項１乃至請求項４のいずれか一において、前記第１トランジスタ乃至第３トランジスタは、チャネルにシリコンを有するトランジスタである、二次電池の制御回路。

【請求項８】

請求項１乃至７のいずれか一に記載の二次電池の制御回路と、

二次電池と、筐体と、

を有する電気機器。